新規なエアロゾル化ガスデポジションによるアルミナ絶縁膜の作製

開発製品の技術の概要

ガス搬送過程で静電荷電された微粒子を効率よく成膜に利用すること、および原料粉の混入などを避けることを目的にして、ノズルからの噴射粒子を一度平板ターゲットに衝 突させ、その衝突によりプラズマを発生させ、その過程で生成した活性ナノ粒子のみを利用する新規成膜方法T-AGDを考案した。従来法のノズル方式AGDに比べ、原料粉が 混入しない、微細ナノ粒子の緻密膜が形成できる。さらに、大面積・高速成膜の安定対応のために、成膜への寄与を終えた粉を形成膜に混入させないため、新規のマスク付き ターゲット方式Tm-AGD成膜装置を発明した。

本技術が解消できる現状の課題およびその方法

従来技術·製品

課題

薄くても高い絶縁 性のあるアルミナ 膜が高速成膜でき る装置

解消方法

ノズルから噴射された原料微粉を一度ターゲット板に衝 突させ、プラズマを誘起させ、その場で生成される活性 種 (原子あるいは微細ナノ粒子) を使用して、基板上に 緻密な膜形成を行うセラミックスの常温成膜方法

AGD法はセラミックスの常温成膜である。微粒子を噴射 堆積させる従来のAGDは粉の膜内混入が避けられない。 プラズマスプレー法、電子ビーム物理蒸着法および レーザーCVD法は高温成膜であり、スパッタ法は成膜速 度が遅い。

37

進捗状況

現状の課題

中量販売準備中

弊社規模では、生産機の製造は数台/年程度と考えられる。それ以外はライセンス先製造。業務提携先と共同開発を行い、T-AGD量産装 置を作る。常温セラミックス成膜装置の製造販売および成膜受託事業である。

従来技術に対する新規性・優位性

アルミナ成膜法にはスパッタ法やCVD法があるが、本T-AGD法は、それらに 比べ成膜速度が桁違いに速い。また、他のプラズマスプレー法、レーザー CVD法および電子ビーム物理蒸着法に比べ、常温成膜に優位性がある。

想定される活用例

電気絶縁および遮蔽コーティング膜への適用。アルミナ絶縁膜の要求特性は、数 $10 \mu m$ 程度の厚みで、絶縁破壊電圧が2kVを超える。成膜サイズは $300mm \phi$ など。電気を通さな いのであれば、遮蔽コーティング膜としても実用化できる。

マッチング先の要望

提携要望分野

提携希望先

マッチングが想定できる業種・企業名

最重要 提携要 望分野

技術 提携

技術提携

メーカー

電気機器メーカー、自動車メーカー、携帯端末メーカー、半導体製造メーカー、半導体関 連装置メーカーなど、真空装置の取り扱いがある企業、機械装置メーカー、デバイスメー カーの生産子会社など

企業名

有限会社渕田ナノ技研

知的財産情報

技術の詳細等

登録済:海外登録

設立年

2004/5

資本金(百万円)

取締役社長 渕田英嗣

代表者氏名

本社

役職

部署

連絡先

社長

氏名 渕田英嗣

E-mail

TEL

029-856-3935

住所

茨城県つくば市苅間1561-3

e.fuchita@nanotechepd.com

会社URL

http://www.nanotechepd.com

技術資料ダウンロードURL

http://www.nanotechepd.com/recruit.html

デモンストレーション動画

NEDO支援事業概要および年度

平成29年度第2回ベンチャー企業等による新エネルギー技術革新支援事業(燃 料電池・蓄電池)/静電気誘導プラズマ成膜装置のセラミックス粉連続安定供給 エアロゾル化機構の技術開発(2017年度)

新規のマスク付きターゲット方式 AGD 成膜装置

セラミックス粉を常温成膜するエアロゾル化ガスデポジション (AGD)は、環境・エネル ギー分野、耐熱材料分野、電子・デバイス分野などの研究開発が進められている。我々は、 薄くて電気絶縁に優れた絶縁膜を高速レートで成膜できるセラミックスの常温成膜装置の 研究開発を進めている.

AGD 成膜は、原料粉をガス搬送しノ ズルから基板上へ噴射・堆積する方法 である. 原料粉を基板へ直接噴射させ ると、形成膜内に大きな粒子が取り込 まれ、その周りには、隙間ができ絶縁 性を阻害する。そこで、従来の AGD 装 置を改良し,新たにターゲット方式 AGD を開発し、ターゲット面からの活 性種・微細ナノ粒子のみが飛来する方

法で成膜を行い、高い絶縁 破壊電界強度を持つアルミ ナ膜を得ていた.

最近, 大面積・高速成膜の 安定対応のために,成膜へ の寄与を終えた粉を形成膜 に混入させないため、ノズ ル入射に対するターゲット 面での正反射方向などの飛

mask and substrate. 1.0x10⁻⁸ T-AGD alumina film Thickness; 16µm N60/T105-G45, 99deg Mask, He gas 1.0x10⁻⁹ 1.0x10⁻¹ •1 **=**2 ±3 **=**4 •5 1.0x10⁻¹²

Fig. 2 Volt-ampere characteristics (A) 99 deg.

Nozzle angle

Fig.1 Tm-AGD. Illustrations of nozzle, target,

来粒子をカットする必要があると考え、

新たなマスク板を追加して成膜(Tm-AGD)したところ、良好な膜質が安定して得られた。

会社URL



技術資料ダウンロードURL

デモンストレーション動画 URL

NEDO

イノベーションジャパン2020バーチャルビジネスマッチング(VIJ2020BM) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 イノベーション推進部 統括グループ

有限会社渕田ナノ技研

技術の詳細等

新規のマスク付きターゲット方式 AGD 成膜装置

セラミックス粉を常温成膜するエアロゾル化ガスデポジション (AGD)は、環境・エネルギー分野、耐熱材料分野、電子・デバイス分野などの研究開発が進められている。我々は、薄くて電気絶縁に優れた絶縁膜を高速レートで成膜できるセラミックスの常温成膜装置の研究開発を進めている。

AGD 成膜は、原料粉をガス搬送しノ ズルから基板上へ噴射・堆積する方法 である。原料粉を基板へ直接噴射させ ると、形成膜内に大きな粒子が取り込 まれ、その周りには、隙間ができ絶縁 性を阻害する。そこで、従来の AGD 装 置を改良し、新たにターゲット方式 AGD を開発し、ターゲット面からの活 性種・微細ナノ粒子のみが飛来する方

法で成膜を行い,高い絶縁 破壊電界強度を持つアルミ ナ膜を得ていた.

最近,大面積・高速成膜の 安定対応のために,成膜へ の寄与を終えた粉を形成膜 に混入させないため,ノズ ル入射に対するターゲット 面での正反射方向などの飛

来粒子をカットする必要があると考え,

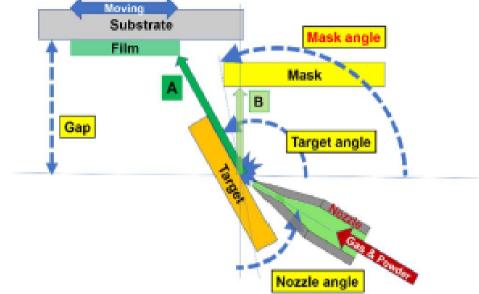


Fig.1 Tm-AGD. Illustrations of nozzle, target, mask and substrate.

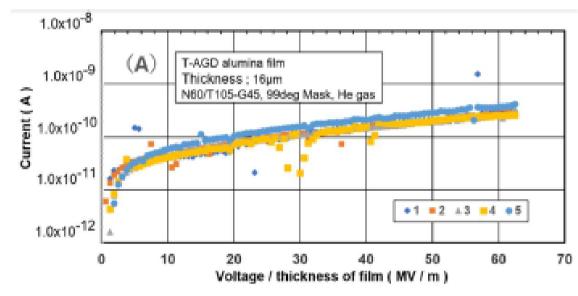


Fig. 2 Volt-ampere characteristics (A) 99 deg.

新たなマスク板を追加して成膜 (Tm-AGD) したところ、良好な膜質が安定して得られた。